

# SiC晶圆CMP抛光用半游离磨料抛光垫 " LHA PAD "

**NORITAKE CO.,LTD.**  
**<http://www.noritake.co.jp>**

# 现行SiC晶圆二次研磨抛磨加工存在的問題

一次研磨 (DMP)  
为更注重加工效率的  
粗磨



二次研磨 (CMP)  
为更注重表面质量的  
精磨

现行二次研磨工艺 费工费时

需要至少两台不同粒度抛光设备  
使用昂贵的浆料

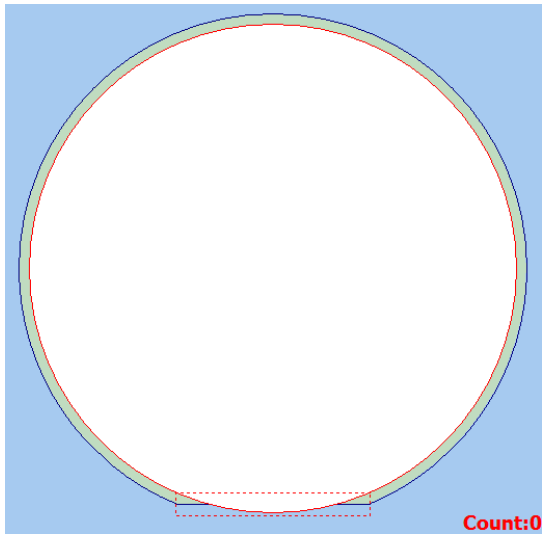
加工成本高

现行二次研磨抛光工艺非常容易造成晶圆划伤

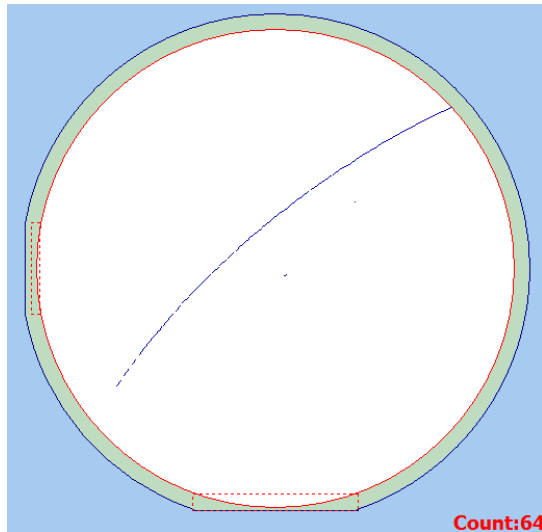
新开发的LHA PAD抛光垫 使二次研磨CMP工艺实现  
在一台设备上一次性加工 + 无划痕高质量晶圆

# 二次研磨 (CMP) 晶圆划痕对比

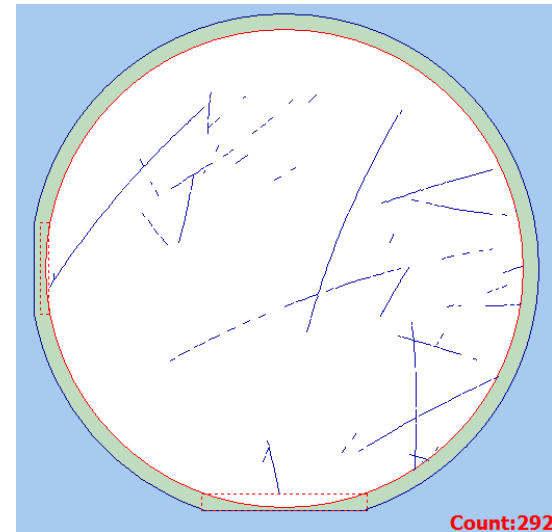
LHA抛光垫  
/不含磨料磨削液



无纺布抛光垫  
/含磨料浆料



聚氨酯抛光垫  
/含磨料浆料



# LHA 抛光垫规格

项目	内容
外径	$\phi$ 940mm 以下（可根据用户具体需求） ※ $\Phi$ 1300mm 产品试制中
厚度	1.5mm（标准）
沟槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 带同心圆沟槽 的标准型                             <ul style="list-style-type: none"> <li>┌ 沟槽 间距 1mm 以上（标准5mm）</li> <li>├ 沟槽 宽度 0.5mm 或者 1mm</li> <li>└ 沟槽 深度 0.6mm 以下</li> </ul> </li> <li>• 无沟槽型</li> </ul>
缓冲垫	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有（标准型）</li> <li>• 无</li> </ul>
耐酸碱范围	PH=1~11

注) 由于尚为开发阶段产品，表中规格数据并非保证值，可能会变更调整。